

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-217551

(43)Date of publication of application : 02.08.2002

(51)Int.Cl.

H05K 3/46

B23K 26/00

H05K 3/00

H05K 3/26

(21)Application number : 2001-227216

(71)Applicant : TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing : 27.07.2001

(72)Inventor : MAEHARA MASATAKA  
MAKINO KATSUSHI  
OKUMA TAKAMASA

(30)Priority

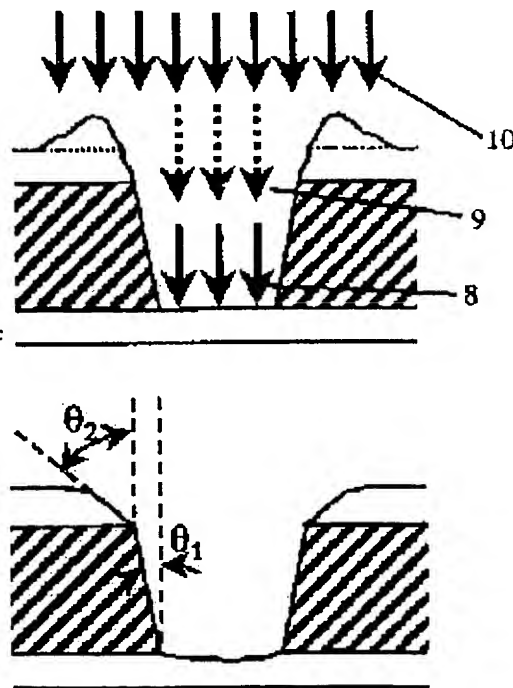
Priority number : 2000349231 Priority date : 16.11.2000 Priority country : JP

## (54) MULTILAYER WIRING SUBSTRATE AND ITS MANUFACTURING METHOD, AND LASER DRILL DEVICE

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a multilayer wiring substrate and its manufacturing method, and a laser drill device for removing dross generated in a hole opening end for via hole formation by means of laser drill processing, without having to use special processes such as physical polishing and chemical polishing.

**SOLUTION:** In a manufacturing method of a multilayer wiring substrate which is formed by laminating an insulation layer formed of a resin insulation film and a wiring layer alternately formed of a conductor film, after a hole part for via hole formation is formed from a wiring layer side of a multilayer wiring substrate by means of laser drill processing, dross generated in a hole part opening end is removed by using the laser drill. The laser drill is a ultraviolet laser drill, using a single wavelength of 355 nm or lower, and a laser processing diameter which is larger than a hole part processing diameter by 0.1 to 100  $\mu\text{m}$  rather than the laser processing diameter in forming a hole part is used, when dross generated in a hole part opening end is removed.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted]

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Copyright (C); 2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-217551

(P2002-217551A)

(43) 公開日 平成14年8月2日(2002.8.2)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	ターミナル <sup>*</sup> (参考)
H 0 5 K 3/46		H 0 5 K 3/46	X 4 E 0 6 8 N 5 E 3 4 3
B 2 3 K 26/00		B 2 3 K 26/00	H 5 E 3 4 6
H 0 5 K 3/00		H 0 5 K 3/00	N
3/26		3/26	B
審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 8 頁)			

(21) 出願番号 特願2001-227216(P2001-227216)

(22) 出願日 平成13年7月27日(2001.7.27)

(31) 優先権主張番号 特願2000-349231(P2000-349231)

(32) 優先日 平成12年11月16日(2000.11.16)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000003193

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72) 発明者 前原 正幸

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

(72) 発明者 牧野 勝史

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

(72) 発明者 大熊 隆正

東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

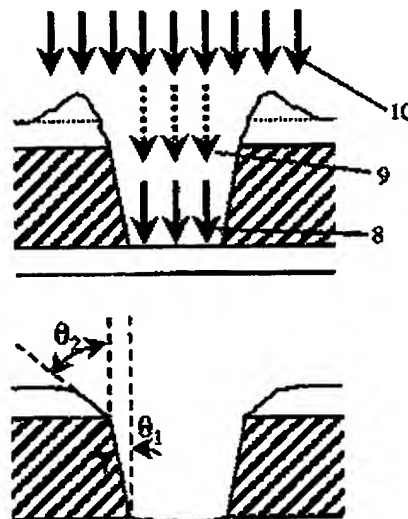
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多層配線基板及びその製造方法、並びにレーザードリル装置

(57) 【要約】

【課題】ビアホール形成用の孔開口端に発生するドロスの除去を物理研磨や化学研磨等の専用工程を用いることなくレーザードリル加工で行う多層配線基板及びその製造方法、並びにレーザードリル装置を提供する。

【解決手段】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板の製造方法において、多層配線基板の配線層側からビアホール形成のための孔部をレーザードリル加工を用いて形成後に、前記レーザードリルを用いて孔部開口端に発生するドロスを除去する。なお、レーザードリルが355nm以下の単一波長を用いた紫外線レーザードリルであること、孔部を形成する際のレーザ加工直径よりも、孔部開口端に発生するドロス除去をする際に孔部加工径より



(2)

特開2002-217551

1

2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板の製造方法において、多層配線基板の配線層側からビアホール形成のための孔部をレーザードリル加工を用いて形成後に、前記レーザードリルを用いて孔部開口端に発生するドロスを除去することを特徴とする多層配線基板の製造方法。

【請求項2】レーザードリルが355nm以下の単一波長を用いた紫外線レーザードリルであることを特徴とする請求項1記載の多層配線基板の製造方法。

【請求項3】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板をレーザードリル加工する順序が、上面配線層、中間樹脂絶縁層、孔部開口端ドロスであることを特徴とする請求項1又は2記載の多層配線基板の製造方法。

【請求項4】孔部を形成する際のレーザ加工直径よりも、孔部開口端に発生するドロス除去をする際に孔部加工径より0.1～100μm大きいレーザ加工径を用いることを特徴とする請求項1～3の何れかに記載の多層配線基板の製造方法。

【請求項5】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板における同一面内の個々の孔部形成後に開口端のドロスを除去するバースト加工、もしくは多層配線基板における同一面内のすべての孔部形成後にそのすべての孔部開口端のドロスを再度同じ軌跡にて除去するサイクル加工の少なくともどちらか一方を行うことを特徴とする請求項1～4の何れかに記載の多層配線基板の製造方法。

【請求項6】前記請求項1～5の何れかに記載の多層配線基板の製造方法により、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板において貫通孔部および止まり穴加工の少なくともどちらか一方、あるいは両方が形成されていることを特徴とする多層配線基板。

【請求項7】前記請求項1～5の何れかに記載の多層配線基板の製造方法により、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなるリジットおよびフレキシブル回路基板の少なくともどちらか一方において、上下の金属配線層の導通をとるための孔部が形成されていることを特徴とする多層配線基板。

【請求項8】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板の製造に用いるレーザードリル装置において、多層配線基板の配線層側からビアホール形成のための孔部を形成する

る配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板を、上面配線層、中間樹脂絶縁層、孔部開口端ドロスの順でレーザードリル加工を行なうことを特徴とする請求項8記載のレーザードリル装置。

【請求項10】孔部を形成する際のレーザ加工直径よりも、孔部開口端に発生するドロス除去をする際に孔部加工径より0.1～100μm大きいレーザ加工径を用いることを特徴とする請求項8又は9記載のレーザードリル装置。

【請求項11】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板における同一面内の個々の孔部形成後に開口端のドロスを除去するバースト加工、もしくは多層配線基板における同一面内のすべての孔部形成後にそのすべての孔部開口端のドロスを再度同じ軌跡にて除去するサイクル加工の少なくともどちらか一方を行うことを特徴とする請求項8～10の何れかに記載のレーザードリル装置。

【請求項12】樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板をレーザードリル加工する順序が上面配線層、中間樹脂絶縁層、孔部開口端ドロスである場合に、孔部開口端ドロスを加工すると同時に上面配線層にテーパ角度をつけることでめっき時の液流れを改善したビアホール用孔部の製造方法。

【請求項13】前記請求項12記載のビアホール用孔部において、上面配線層でのテーパ角度と中間樹脂絶縁層のテーパ角度の比（中間樹脂絶縁層／上面配線層）が0.40～1.00であることを特徴としたビアホール用孔部の製造方法。

【請求項14】前記請求項12記載のテーパ角度のついたビアホール用孔部の製造方法を用いたリジットおよびフレキシブル回路基板の少なくともどちらか一方の多層配線基板。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、金属配線層の層間接続用に形成されるビアホール形成のための孔部開口端に発生するドロス除去方法およびこれを用いた多層配線基板に関するものである。さらに詳しくは、多層配線基板、プリント配線板、高密度実装用の印刷回路の層間絶縁層に形成される層間接続用のビアホールを用いた多層配線基板及びその製造方法、並びにレーザードリル装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体の集積度が飛躍的に増進し、半

(3)

特開2002-217551

3

【0003】多端子化した半導体を実装するため、配線基板にも配線の細線化（高密度化）が要求されるが、製造方法が困難なことから配線基板を多層化することにより配線の細線化を緩和する対策がとられている。多層化に際し、孔部を形成し導通可能な金属材料を孔部内に皮膜することで樹脂絶縁層を挟んだ上下の金属配線層間の層間接続がとられる。

【0004】従来、層間接続のための孔部を形成する場合には金属ドリルによる機械加工が主流だった。しかし孔部が微細になれば当然加工するドリルも小さくなるが、微小ドリルは作製にコストが掛かり、加工時の摩耗も激しい消耗品であった。そこで近年、微小孔部の形成には金属ドリルの機械加工に代わり、高エネルギーのレーザー光を照射し、加工対象物に吸収させ熱加工するレーザー加工（それに用いる装置をレーザードリル装置という）が近年用いられるようになってきた。

【0005】レーザー加工に用いるレーザー光は赤外線領域のCO<sub>2</sub>レーザー（波長9.3～10.6μm）、YAGレーザー（基本波の波長1.06μm）、紫外線領域のYAG、YLF、YAP、YVO<sub>4</sub>レーザー（第3高調波の波長355nm、第4高調波の波長266nm）およびエキシマレーザー（XeClの波長308nm、KrFの波長248nm、ArFの波長193nm）が現在、加工機のレーザー光として利用されている。赤外線領域の波長を利用したレーザー加工は金属ドリルにおける機械加工に対し熱加工や熱分解加工であり、紫外線領域の波長を利用したレーザー加工は光化学反応を利用した光分解加工と呼ばれている。

【0006】金属ドリルによる機械加工は貫通孔部の形成が主流であるが、レーザー加工はパルス発振であるので絶縁層のみの加工（穴止め加工；図1）が可能である。そのためレーザー加工は配線基板のブラインドホール加工を主に使用されている。現在、実用化されている孔部径の各径レーザー光による棲み分けは、CO<sub>2</sub>レーザーがφ50～150μm、紫外線レーザーがφ30～80μmである。エキシマレーザーはφ20μmのようなより微小径も加工可能であるが、高反射性の金属酸化膜マスクやレーザー媒体ガスの維持等の消耗品が高価なため量産には向かない。しかしながら前記棲み分けも、配線基板の高密度化に伴い紫外線レーザーによる孔部形成が有望視されている。

【0007】また配線層の形成には、例えば金属配線層の材質が銅である場合、全面銅箔層から配線化する製造方法（サブトラクティブ法）と配線の逆パターンを中間絶縁層に形成し、金属配線層を形成する（アドヒーズ法）とがある。

4

製造方法の工程数が少なく、量産に向いている。また近年、サブトラクティブ法の技術の向上により、セミアディティブ法の微細配線に迫る細線化が可能との報告もある。

【0008】レーザードリル加工による孔部形成とサブトラクティブ法による配線形成により多層配線基板が形つくられる。加工順序は全面銅箔層に対しレーザードリル加工を施し、孔部の形成後に孔部内壁を例えば電気化学的手法により金属物質で被覆した後、エッチングレジストをパターンニングし塩化第二鉄液等のエッチング液により銅配線を形成する。

【0009】ここでレーザードリル加工の対象が樹脂絶縁層のみの場合は、CO<sub>2</sub>および紫外線レーザーで孔部形成が可能であるが、金属配線層と樹脂絶縁層を同時に加工する（ダイレクト加工）必要がある。しかしながら、CO<sub>2</sub>レーザーであると金属配線層の吸収波長域でないためレーザー光が銅箔に吸収されず反射してしまう。

【0010】前記問題を解消するために、金属配線層を黒化処理してCO<sub>2</sub>レーザー光を吸収させる方法や、公知のフォトリソグラフィ（フォトリソ）によって金属配線層を穴状にパターンニングした後にレーザーによるピア加工を行う方法（コンフォーマル加工）が実施されている。しかしながらこれらの方法は配線基板の製造工程が増えるため、製造コスト面で問題がある。

【0011】紫外線レーザーの波長は金属の吸収波長と重なるためにダイレクト加工が可能である。またエネルギー密度が高いため微小径でもレーザー加工可能である。しかしながら金属の吸収波長であるとはいえ、金属に対しては熱加工的な要素が強く銅箔が溶解することで、孔部が図1のように形成される。ここでレーザー光の高エネルギーにより溶解した銅は図1に示す形状6となる。1つの孔部を形成するために数パルス～数十パルス照射するので、孔部開口端に溶解した銅が盛り上がる形でドロスとなる。図1はレーザードリル加工後の孔部の上面図と断面図を示す。

【0012】ドロス6が残存したまま、例えば電解めっき等で孔部内を銅で充填しようとする、局所的に凹凸のあるドロスの部分に電界が集中し上面銅層での電解銅の成長が早くなり、孔部内に電解銅が充填する前に上面銅層で空間が閉じてしまう。結果的に空隙が孔部内に残ってしまうことになる。このために孔部をレーザードリル加工した後は必ずドロスを除去しなければならない。

【0013】従来のドロス除去には、研磨シートや研磨液を用いた機械研磨や、超音波洗浄などがある。

(4)

特開2002-217551

5

法も工程ラインが1つ以上増えるため、製品信頼性および生産性の面で問題があった。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記のような問題点を解決するためになされたものであり、複数の樹脂絶縁層と金属配線層からなる多層配線基板に対し、上下の金属配線層を接続させるための孔部形成に際し、ビアホール形成用の孔開口端に発生するドロスの除去を物理研磨や化学研磨等の専用工程を用いることなくレーザードリル加工で行う多層配線基板及びその製造方法、並びにレーザードリル装置を提供することを目的とする。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明において上記課題を達成するために、まず請求項1の発明では、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板の製造方法において、多層配線基板の配線層側からビアホール形成のための孔部をレーザードリル加工を用いて形成後に、前記レーザードリルを用いて孔部開口端に発生するドロスを除去することを特徴とする多層配線基板の製造方法である。

【0016】また請求項2の発明では、レーザードリルが355nm以下の単一波長を用いた紫外線レーザードリルであることを特徴とする請求項1記載の多層配線基板の製造方法。

【0017】また請求項3の発明では、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板をレーザードリル加工する順序が、上面配線層、中間樹脂絶縁層、孔部開口端ドロスであることを特徴とする請求項1又は2記載の多層配線基板の製造方法である。

【0018】また請求項4の発明では、孔部を形成する際のレーザー加工直径よりも、孔部開口端に発生するドロス除去をする際に孔部加工径より0.1～50μm大きいレーザー加工径を用いることを特徴とする請求項1～3記載の多層配線基板の製造方法である。

【0019】また請求項5の発明では、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板における同一面内の個々の孔部形成後に開口端のドロスを除去するバースト加工、もしくは多層配線基板における同一面内のすべての孔部形成後にそのすべての孔部開口端のドロスを再度同じ軌跡にて除去するサイクル加工の少なくともどちらか一方を行うことを特徴とする請求項1～4記載の多層配線基板の製造方法である。

【0020】また請求項6の発明では、前記請求項1～

6

特徴とする多層配線基板である。

【0021】また請求項7の発明では、前記請求項1～5に記載の多層配線基板の製造方法により、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなるリジッドおよびフレキシブル回路基板の少なくともどちらか一方において、上下の金属配線層の導通をとるための孔部が形成されていることを特徴とする多層配線基板である。

【0022】また請求項8の発明では、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板の製造に用いるレーザードリル装置において、多層配線基板の配線層側からビアホール形成のための孔部を355nm以下の単一波長を用いた紫外線レーザードリル手段を用いて形成後に、前記レーザードリル手段を用いて孔部開口端に発生するドロスを除去することを特徴とするレーザードリル装置である。

【0023】また請求項9の発明では、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板を、上面配線層、中間樹脂絶縁層、孔部開口端ドロスの順でレーザードリル加工を行なうことを特徴とする請求項8記載のレーザードリル装置である。

【0024】また請求項10の発明では、孔部を形成する際のレーザー加工直径よりも、孔部開口端に発生するドロス除去をする際に孔部加工径より0.1～50μm大きいレーザー加工径を用いることを特徴とする請求項8又は9記載のレーザードリル装置である。

【0025】また請求項11の発明では、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板における同一面内の個々の孔部形成後に開口端のドロスを除去するバースト加工、もしくは多層配線基板における同一面内のすべての孔部形成後にそのすべての孔部開口端のドロスを再度同じ軌跡にて除去するサイクル加工の少なくともどちらか一方を行うことを特徴とする請求項8～10記載のレーザードリル装置である。

【0026】また請求項12の発明においては、樹脂絶縁膜よりなる絶縁層と導体膜よりなる配線層とが交互に積層されてなる多層配線基板をレーザードリル加工する順序が上面配線層、中間樹脂絶縁層、孔部開口端ドロスである場合に、孔部開口端ドロスを加工すると同時に上面配線層にテーパ角度をつけることでめっき時の液流れを改善したビアホール用孔部の製造方法であることを特徴とする。

【0027】また請求項13の発明においては、前記請求

(5)

特開2002-217551

7

【0028】また請求項13の発明においては、前記請求項12記載のテーパ角度のついたビアホール用孔部の製造方法を用いたリジットおよびフレキシブル回路基板の少なくともどちらか一方の多層配線基板としたものである。

【0029】

【発明の実施の形態】以下、本発明の多層配線基板の製造方法（特にドロス除去）について説明する。微細配線を形成する際にはサブトラクティブ法とセミアディティブ法が現在有望視されている。サブトラクティブ法は銅箔上にレジストコート-露光-現像-エッチング工程により銅配線が完成する。一方、セミアディティブ法は樹脂上に無電解めっき-レジストコート-露光-現像-電解めっき-ソフトエッチングすることによって銅配線が完成する。無電解めっきにより全面に析出した銅はソフトエッチングにより独立パターンの銅配線となる。さらにセミアディティブ法による銅配線形成時のめっきは工程時間が非常にかかり、生産性向上の障害となる。

【0030】配線形成にサブトラクティブ法を採用するにあたり、レーザードリル加工には銅箔直接加工（ダイレクト加工）が求められる。CO<sub>2</sub>レーザーでは金属における吸収波長ではないため、銅箔表面に黒化処理等を施して加工する必要がある。その点、紫外線レーザーであれば金属における吸収波長であるため、黒化処理等の特殊な処理を施さずにレーザードリル加工を行うことができる。

【0031】紫外線レーザー加工機はパルス発振であるので、単位面積あたりのレーザー光のパルスエネルギーを銅箔層と樹脂層との間で変えることによって、図1のような穴止め加工（ブラインドビア）を行うことができる。例えば、YAGの第3高調波（波長355nm）を利用した銅箔層加工には10J/m<sup>2</sup>以上、樹脂加工には1～3J/m<sup>2</sup>程度のエネルギーが必要である。このエネルギー差を利用して、上面銅箔層には10J/m<sup>2</sup>、その後樹脂層に3J/m<sup>2</sup>のエネルギーを加工可能なパルスショット数を照射することによってブラインドビアを形成することができる。またレーザー光の強度分布は孔部の中心部ほど強く、孔部端になるほど弱くなる。すなわちレーザー強度の弱い部分では加工が進行しないため、孔部はテーパ形状となる。

【0032】金属層ダイレクト加工を行った後の孔部の開口端には図1の6のように盛り上がった形状のドロスが発生する。この盛り上がりの膜厚は1～3μm程度である。このドロスをレーザードリルで除去するためには、

8

うことができる（図2参照）。これには銅の吸収波長を考慮すると355nm以下の紫外線波長のレーザー光を用いることが効果的である。CO<sub>2</sub>レーザーでは吸収波長でないために、ドロスに対し再度黒化処理等を施す必要があり、結果的に工程数が増える。ドロスを直接レーザードリル加工で除去する過程で留意しなければならないことは、ドロス除去時のパルス数を過剰に増やすと孔底部の銅箔がドロスと同時に加工されてしまい、ブラインドビアが貫通してしまうことが考えられる。レーザードリル加工における1パルス当たりの加工レートはレーザー発振条件にも依るが、1μmに満たない加工レートも容易である。このためドロス除去のパルス数の適正值としては、ドロスの膜厚を正確に把握した上で決定することが望ましい。また第1の銅箔加工時のパルスエネルギーより低いパルスエネルギーをドロス除去のパルスエネルギーとして照射しても構わない。例えば第1の銅箔加工時に10J/m<sup>2</sup>であれば、ドロス除去時には8～9J/m<sup>2</sup>のパルスエネルギーを照射することである。

【0033】またドロス発生範囲以上の径のレーザードリル加工を行うと、以降の配線形成工程において配線となるべき銅箔の膜厚を減少させてしまう可能性があるため、ドロス除去を行うレーザー光の径はドロス発生の径そのものであった方が望ましい。一方で、銅配線層の初期の膜厚がドロス除去時の加工膜厚に比べ問題にならない程度であれば、ドロス除去のレーザー光の径が決定される必要はない。

【0034】またある単位径のレーザー光を螺旋運動させ、所望の孔部径まで広げる加工方式（トレパニング法）である場合、第2の樹脂加工まで行ったら単位径をドロス上のみ同様に螺旋運動させることでドロス除去を行うことができる。この場合、ドロスのみ加工されるので孔底部が加工されることはない。

【0035】ドロス除去をレーザードリル手段で行うことにより、3段階のレーザー光照射が必要になる。すなわち加工スループットの低下が考えられるが、ドロス除去のための照射パルス数はドロスの膜厚にも依存するが、数パルスであるので金属層および樹脂層加工時のパルス数に比べ相対的に少ないパルス数で済む。金属層+樹脂加工のみによるブラインドビア加工時に対し、金属層+樹脂層+ドロス除去によるブラインドビア加工での加工スループットは90～99%程度である。

【0036】また金属層+樹脂層+ドロス除去加工の加工順序は、1つの孔部を形成後に次孔部を加工するバーストモードおよび金属層の加工条件のまますべての孔部



【００４１】以下、本発明のドロス除去方法を用いた多層配線基板について説明する。金属層（銅）に第１のレーザードリル加工、次に絶縁層に第２のレーザードリル加工、最後にドロス部に第３のレーザードリル加工を適正なレーザー照射量およびショット数により加工することで、ドロスの除去された孔部形成をレーザードリル手段のみにより行うことができる。レーザードリル加工（手段）でドロスが除去されることによって、レーザードリル加工後の物理研磨や化学研磨等の専用ドロス除去工程が省略され、製品の生産性が向上する。またドロス

10

45

http://www4.indl.ncipi.go.jp/ticontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web... 3/23/2005

(7)

特開2002-217551

11

同様に過マンガン酸水溶液によりデスミア処理を施した。その後、上下金属層の層間導通をとるために電解銅めっきを行った。めっき液の組成は硫酸銅225g/L、硫酸55g/L、塩素イオン60mg/L、添加剤20mLであり浴温を25℃とし、攪拌を行いながら陰極電流密度を1.0A/dm<sup>2</sup>で60分電解めっきを行った。電解めっき後に90℃で10分間、サンプルを乾燥させた。

【0048】前記2種類のサンプルを樹脂に充填し50℃で1時間加熱硬化させ、グラインダーによって研磨し、孔部内の銅充填不良率を調べた。レーザードリル加工によりドロスが除去された基板と物理研磨によりドロスが除去された基板の銅充填不良率は、5～3%であった。しかしドロスの除去されていない基板の銅充填不良率は50～60%であった。これは電解めっき工程においてドロスの凸部では電界集中が起こり、孔開口部での電解銅の成長が孔底部での電解銅成長よりも早く、孔内部に空隙が残されたためと考えられる。

【0049】さらに1000穴格子状のパターンを、上下の配線層を交互に結線する鎖状のパターンに回路を形\*20

試験項目/試験方法	ドロス有り基板	ドロス除去基板① (物理研磨)	ドロス除去基板② (レーザードリル加工)
ヒートサイクル試験 (-25℃～125℃)	0～20サイクル	500サイクル以上	500サイクル以上
絶縁信頼性試験 (80℃85%DC50V, 1000h)	異常なし	異常なし	異常なし

【0053】

【発明の効果】本発明の多層配線基板の製造方法及びレーザードリル装置によれば、レーザードリル加工後のドロス除去専用工程（例えば物理研磨や化学研磨）を省略することができ、金属配線層と樹脂絶縁層とが交互に積層してなる多層配線基板において基板製造の短縮化でき、また孔部形成後の薬液処理による液流れを改善するため歩留まり向上になる。また基板製造の短縮化によって、基板への負荷（基板の収縮および表面改質、樹脂絶縁層への吸湿）を回避することができる。

【0054】

【図面の簡単な説明】

【図1】両面銅箔付き樹脂フレキシブル基板における穴止め（ブラインドビア）加工の上面図および断面図である。

【図2】レーザードリル加工によるドロス除去を示す説明図である。

12

\*成しテスターによる導通試験を行った。完全導通したサンプルのみ合格品とし、断線があるものは不良とした。レーザードリル加工によってドロスの除去され、かつテーパー角度を備えたサンプルは95%の歩留まりだったのに対し、ドロスの除去しないサンプルは67%の歩留まりだった。

【0050】またレーザードリル加工によりドロスを除去しているため、ドロス除去専用工程である物理研磨工程が省略され、製造工程を短縮化できた。レーザー加工工程から電解めっき工程までのサンプル基板を作製するに要した時間は15%短縮した。

【0051】基板信頼性評価試験としてヒートサイクル試験と絶縁信頼性試験を行った。ヒートサイクル試験は-65℃×30min～165℃×30minで行い、絶縁信頼性試験は上下層間のL/S=50μm/50μmのくし型パターンにて、80℃/85%/50V、1000時間後の値を測定した。試験結果を表1に示す。

【0052】

【表1】

【図3】レーザードリル加工後における上面配線層のテーパー角度（ $\theta_1$ ）および中間樹脂絶縁層におけるテーパー角度（ $\theta_2$ ）を示す説明図である。

【図4】テーパー角度を備えた孔部へのめっき処理時における薬液流れを示す説明図である。

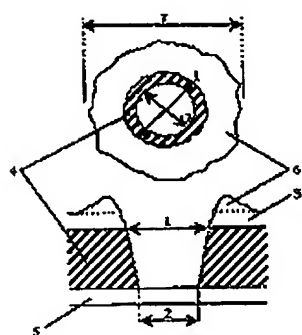
【符号の簡単な説明】

- 1 孔部開口径
- 2 孔部底部径
- 3 上面金属配線層
- 4 絶縁樹脂層
- 5 下面金属配線層
- 6 ドロス
- 7 ドロス径
- 8 上面金属配線層加工用レーザーパルス光
- 9 絶縁樹脂層加工用レーザーパルス光
- 10 ドロス除去用レーザーパルス光

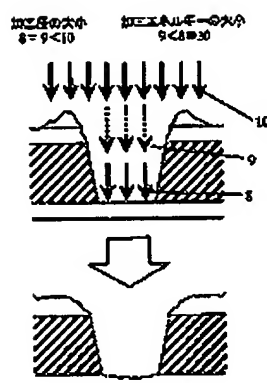
(8)

特開2002-217551

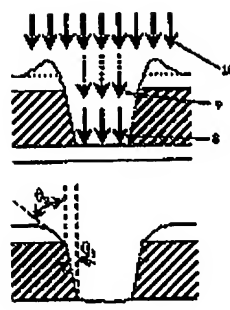
【図1】



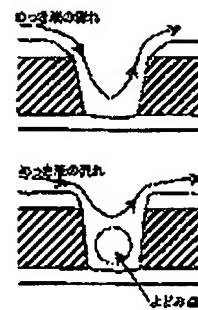
【図2】



【図3】



【図4】




---

フロントページの続き

Fターム(参考) 4E068 AA05 AF00 CG00 DA11  
 5E343 AA07 AA18 BB24 BB67 DD43  
 EE01 EE12 EE32 EE33 EE43  
 GG11  
 5E346 AA42 AA43 CC10 CC32 DD12  
 FF03 FF14 GG15 HH32

**\* NOTICES \***

**JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

**CLAIMS**

---

**[Claim(s)]**

[Claim 1] the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer -- the manufacture approach of the multilayer-interconnection substrate characterized by to remove the dross which uses said laser drill for the pore for the beer hall formation from the wiring layer side of a multilayer-interconnection substrate after formation using laser drill processing, and is generated at a pore opening edge in the manufacture approach of a multilayer-interconnection substrate of coming by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film.

[Claim 2] The manufacture approach of the multilayer-interconnection substrate according to claim 1 characterized by a laser drill being an ultraviolet-rays laser drill using the single wavelength of 355nm or less.

[Claim 3] the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer -- the manufacture approach of a multilayer-interconnection substrate according to claim 1 or 2 that sequence which carries out laser drill processing of the multilayer-interconnection substrate with which it comes by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film is characterized by being a top-face wiring layer, a middle resin insulating layer, and pore opening edge dross.

[Claim 4] The manufacture approach of a multilayer-interconnection substrate given in any of claims 1-3 characterized by using the diameter of laser processing large 0.1-100 micrometers from the diameter of pore processing in case dross removal generated at a pore opening edge is carried out rather than the laser-processing diameter at the time of forming a pore they are.

[Claim 5] Burst processing the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer -- the dross of an opening edge is removed after pore formation of each within the same field in the multilayer-interconnection substrate with which it comes by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film -- Or the manufacture approach of a multilayer-interconnection substrate given in any of claims 1-4 characterized by the thing of cycle processing which removes the dross of all that pore opening edge by the same locus again after all pore formation within the same field in a multilayer-interconnection substrate for which either is performed at least they are.

[Claim 6] the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer by the manufacture approach of a multilayer-interconnection substrate given in any of said claims 1-5 they are -- the multilayer-interconnection substrate with which the wiring layer which consists of film is characterized by the thing of the through tube section and blind-hole processing for which either or both are formed at least in the multilayer-interconnection substrate which comes to carry out a laminating by turns.

[Claim 7] the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer by the manufacture approach of a multilayer-interconnection substrate given in any of said claims 1-5 they are -- the multilayer-interconnection substrate with which it comes by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film and which is characterized by rigid and forming the pore for taking [ in / at least / either ] the flow of an up-and-down metal wiring layer of the flexible circuit board.

[Claim 8] the insulating layer and the conductor which consist of a resin insulator layer -- the laser-drill equipment characterized by to remove the dross which uses said laser-drill means after formation from the wiring layer side of a multilayer-interconnection substrate using the ultraviolet-rays [ pore / for beer hall formation ] laser-drill means using the single wavelength of 355nm or less, and generates at a pore opening edge in the laser-drill equipment which uses for manufacture of the multilayer-interconnection substrate with which it comes by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film.

[Claim 9] the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer -- the laser drill equipment according to claim 8 characterized by performing laser drill processing for the multilayer-interconnection substrate with which it comes by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film in order of a top-face wiring layer, a middle resin insulating layer, and pore opening edge dross.

[Claim 10] Laser drill equipment according to claim 8 or 9 characterized by using the diameter of laser processing large 0.1-100 micrometers from the diameter of pore processing in case dross removal generated at a pore opening edge is carried out rather than the laser-processing diameter at the time of forming a pore.

[Claim 11] Burst processing the insulating layer and conductor which consist of a resin insulator layer -- the dross of an opening edge is removed after pore formation of each within the same field in the multilayer-interconnection substrate with which it comes by turns to carry out the laminating of the wiring layer which consists of film --